

# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0593U000206

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 28-02-2000

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



## II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Пекар Григорий Соломонович

2. Пекар Григорий Соломонович

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: dashboard/okd.okd\_type\_names.0

Аспірантура/Докторантура: ні

Шифр наукової спеціальності: 01.04.10

Назва наукової спеціальності: Фізика напівпровідників і діелектриків

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 23-04-1993

Спеціальність за освітою: 0104

Місце роботи здобувача: Інститут фізики напівпровідників НАН України

Код за ЄДРПОУ: 05416952

Місцезнаходження: 252022,Київ-22, пр. Науки, 45

Форма власності:

Сфера управління: НАН України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

### **III. Відомості про організацію, де відбувся захист**

**Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради):** Д 016.25.01

**Повне найменування юридичної особи:**

**Код за ЄДРПОУ:**

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

### **IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію**

**Повне найменування юридичної особи:** Інститут фізики напівпровідників НАН України

**Код за ЄДРПОУ:** 05416952

**Місцезнаходження:** 252022, Київ-22, пр. Науки, 45

**Форма власності:**

**Сфера управління:** НАН України

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

### **V. Відомості про дисертацію**

**Мова дисертації:**

**Коди тематичних рубрик:** 61.69.37

**Тема дисертації:**

1. Фізико-технологические исследования и разработки в отрасли получения монокристаллов широкозонных соединений группы A<sub>2</sub>B<sub>6</sub> и их использование в устройствах когерентной и некогерентной оптоэлектроники
- 2.

**Реферат:**

1. Объект исследования: Монокристаллы полупроводниковых соединений группы A<sub>2</sub>B<sub>6</sub> и структуры на их основе. Цель исследования: Определение природы процессов, которые обуславливают рост и формирование физических свойств больших монокристаллов широкозонных соединений группы II-VI при их получении из газовой фазы, создание и установление механизмов работы новых инжекционных источников и детекторов излучения на основе этих соединений. Методы исследования и аппаратура: Эффект Холла, электропроводимость, фотолюминесценция, электролюминесценция, катодолюминесценция, оптическое поглощение и отражение; аппаратура для выращивания кристаллов, спектрометры, электромагнит, лазеры, электроизмерительные устройства. Теоретические результаты и новизна: Выявлена природа высокотемпературных явлений в монокристаллах халькогенидов кадмия, предложена и экспериментально проверена модель асоциатов кадмия, выявлены механизмы работы новых инжекционных источников света и детекторов излучения на основе халькогенидов цинка. Практические

результаты и новизна: Разработан комплекс новых методов выращивания из газовой фазы монокристаллов халькогенидов кадмия и цинка для устройств когерентной оптоэлектроники, разработаны новые инжекционные источники света и детекторы ультрафиолетового излучения. Предмет и степень внедрения: Разработаны методы выращивания монокристаллов используются в полупроводниковой промышленности для получения материалов для лазеров с электронным возбуждением. Сфера (область) использования: Технология полупроводниковых материалов, полупроводниковое приборостроение.

2.

**Державний реєстраційний номер ДіР:**

**Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:**

**Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:**

**Підсумки дослідження:**

**Публікації:**

**Наукова (науково-технічна) продукція:**

**Соціально-економічна спрямованість:**

**Охоронні документи на ОПВ:**

**Впровадження результатів дисертації:**

**Зв'язок з науковими темами:**

## **VI. Відомості про наукового керівника /керівників (консультанта)**

## **VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів**

**Офіційні опоненти**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Лисица М.П.

2. Лисица М.П.

**Кваліфікація:** д.ф.-м.н., 01.04.10

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:**

**Код за ЄДРПОУ:**

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Симашкевич А.В.
2. Симашкевич А.В.

**Кваліфікація:** д.ф.-м.н., 01.04.10

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:**

**Код за ЄДРПОУ:**

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Рудь Ю.В.
2. Рудь Ю.В.

**Кваліфікація:** д.ф.-м.н., 01.04.10

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:**

**Код за ЄДРПОУ:**

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

**Рецензенти**

**VIII. Заключні відомості**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові  
голови ради**

Свечников С.В.

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові  
головуючого на засіданні**

Свечников С.В.

**Відповідальний за підготовку  
облікових документів**

**Реєстратор**

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є  
відповідальним за реєстрацію наукової  
діяльності**



Юрченко Т.А.